1.- Mostrar geometricamente que la estructura centrada en las caras tetragonal es equivalente a una estructura centrada en el cuerpo tetragonal, tales que el lado de la base de las celdas unitarias es $1/\sqrt{2}$ veces mayor que la respectiva al arreglo centrado en las caras. Explicar porque dichas estructuras son distintas.

Sean des estructuras

- i) Estructure contrado en los cerros tetragonal (FGT)
- is) Estructura centrada en el merpo tetragord (BGT)

Unionde des estructures FGT, & esserus que conforman una estructura BGT

Considerando que la longitudes de la BCT, Son: G.b. C, y Leis longitudes de la FCT, son: a',b',c'.

Vease que:

Dade que la base es cuadrada: b'=4' n q=5. Entences:

$$\therefore q = \frac{q'}{m}$$

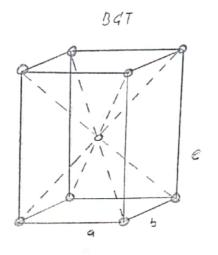
Es deux la base de la BET es 1/12 veces la base de las FET que constituyen a la BET

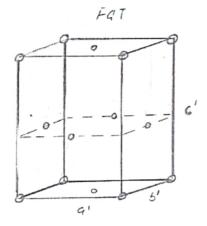
Se observa que: les angules se conservan (900).

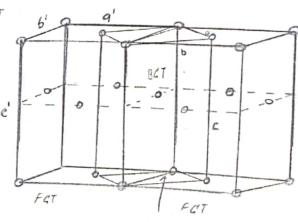
De igual fuima, las alteras: c-d

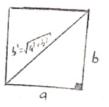
No obstante, la longitud de la base noi q= q1

Por tanto: las estructuras sen distratas









2.- Mostrar que las proporciones maximas de espacio que pueden ser llenadas por un arreglo compacto de esferas en distintas redes, esta dado por:

Cubico simple: $\pi/6$

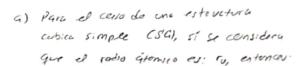
Cubica centrada en el cuerpo: $\pi\sqrt{3}/8$

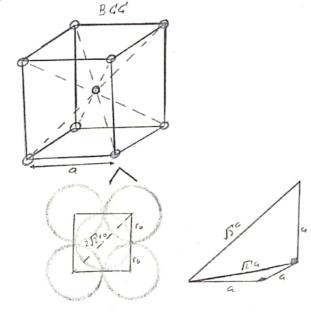
Cubica centrada en las caras: $\pi\sqrt{2}/6$

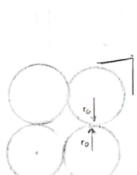
Hexagonal compacta: $\pi\sqrt{2}/6$

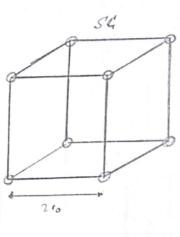
Estructura tipo diamante: $\pi\sqrt{3}/16$

Partiente de la définición del factor le empracetamiento.









b) Para el ceno de una estructura cubico centrado en el cuerpo (B40), si Se considera que el radio atemio es: 10,

Vege que:

$$P_{e} = \frac{(1)\frac{9}{3}\pi(r_{0})^{3}}{4^{3}}$$
 (2 4toma/c.4.)

Ahoro, para el Vulimon de la celda: Vulla = 63

$$Ba = 4r_0$$

$$P_{\mathcal{E}} = \frac{\frac{8}{3} \pi (r_0)^3}{(\frac{4}{15} r_0)^3}$$

a Para el ceso de una estrutura.

cubica centrada en leus caras (FGG), sí

Se considera que el radio atomico es: ru, entonos

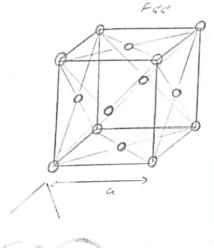
$$P_{E} = \frac{(4)}{3} \frac{4}{3} \pi (r_{0})^{7}$$
(4 4tomos/c.4.)

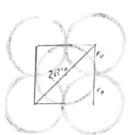
Ahora, Le: q=UIDs, entonav

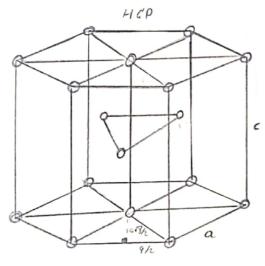
$$P_{E} = \frac{16 \pi r_0^2}{3 (2\sqrt{2}r_0)^3}$$

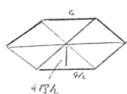
$$\Rightarrow P_{\mathcal{E}} = \frac{\frac{16}{3}\pi r_0^4}{1677r_0^4}$$

$$\rho_{\mathcal{E}} = \frac{R^{2} \bar{\eta}}{6}$$









d) para el ceno de una estructura.

Hexagoral compacts (4GP), st se considere que el radio atomico es to, entences

Donde: 8=60 (perimetro) c Caltura)
$$q_p = q \Pi \quad (q_p otena)$$

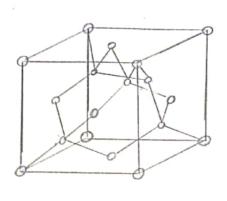
Par tanto:

$$\rho_E = \frac{8\pi}{200} \frac{r_0^3}{62e}$$

De un analysis geometries se obtiene year $q^2c = \frac{16}{10}r_0^3$

e) Para el cum de una estrutura tipo diamente. Si le considera que el rudio atomico es: to, entences:

$$\Rightarrow P_{E} = \frac{\frac{31}{3} \pi r_{0}^{3}}{\frac{512}{373} r_{0}^{3}} = \frac{46 \sqrt{3}}{1536} \pi$$



3.- Discutir (fisicamente) porque un cristal no puede poseer 5 ejes de simetria rotacional.

La estructura cristalina es un conjunto le átemos unidos por enlaces (de algentique), le torma ordenada. Estas estructuras conforman diversas redes geometricas, las cualis, lados los parametros tissicos de enlaces, conforman estructuras complejas, las estructuras cristalinas, mas comunes (IR3), son:

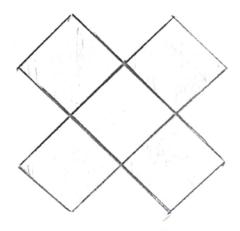
- Cubica centrada en las caras (FGG)
- Cubica contrada en el cuerpo (BCC)
- Cubica simple (48)
- Hexagonal compacta (HCP)

De torma que la mayoria de compuestos salidos trenen alguna de estas estructuras.

Los compuestos tormados per estructuras cristalinas se conforman me diante repeticiones inmensas de lo que se conocen como: celdas unitarias. De torma que si se conocen las distancias argules y ejes de las celdas, se puede conocer la estructura y característicos del material.

Dado que la noturaleza de una estructura enstadona de baso en una combinación geometrica. Assiro, donde se busca que la estructura sec estable, entences hay restricturas para la cacación de estos cristales. Las estructuras cristalanas duelas tener simetrias del tipo: 2,3,4,6





4-Fald

De la condición de: \(\frac{1}{1}, \frac{1}{2} \in \text{LIS] CN, \(\frac{1}{2} \text{KE[IS] CN:} \(\overline{\text{Ti}} + \overline{\text{Tj}} = \overline{\text{Ti}}.\)

Es decir, consquier some de simetrias debe dar como resultato (1665/409), 1500/409)

otra simetrio ya conocido. Veux que

17+ 14 = ((could(20), rsin(1620))+(rcos(480), rsm(180)) (rcos(1620), rsm(620))

= T1 + V4 = (rcos(1620)+ rcos/180), rs.m(1620)+ rsm(180))

De: cos(1620) = - cos(180) 1 sm(1620) = sm(180)

=> T1+ T4= (0, 21)

(rcos(234°), +Sm(234°))

((cos(3060), (sm(3000))

Pero: \$17, 17, 17, 17, 15: 1= (0,21).

Por tanto: 11 y 12 no generan otro eje rotacional canacides por tanto, no se puede

conformer una extructore cristalina con 5 eses de simetria rotacional.

9.- Mostrar apartir de los resultados de la teoria electromagnetica de Maxwell, para onas planas con capacidades de ser buenos conductores ($\sigma \to \infty$, $\kappa \to \infty$, con σ la conductividad y κ la constante dielectrica), se debe esperar una alta superficie reflejante y una fuerte absorción interna.

Sean les ecuaciones de Haxwell:

$$\nabla \cdot \vec{E} = \rho/\epsilon_0 \qquad \nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \qquad \nabla \times \vec{B} = A \cdot \vec{J} + \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = 0$$

Ahora, veax el Laplaciaro del campo electrico: $\nabla^2 \vec{E}$; de la identidad. $\nabla^2 \vec{F} = \nabla (\nabla \cdot \vec{F}) - \nabla X (\nabla X \vec{F})$, entences:

$$\Rightarrow \nabla^2 \vec{E} = \nabla (\beta / \xi_0) - \nabla \times (-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t})$$

De:
$$\nabla G = 0$$
 $\forall G$ constante Λ $\nabla X \partial_t = \partial_t \nabla X$

$$\Rightarrow \nabla^2 \vec{E} = \frac{\partial}{\partial t} (\nabla x \vec{B})$$

$$\Rightarrow \ \, \nabla^2 \overline{E} = \ \, \frac{\partial}{\partial t} \left[\, \mu_0 \, \sigma \, \overline{E} \, t \, \, \frac{1}{c^2} \, \, \frac{\partial \overline{E}}{\partial t} \right]$$

$$\nabla^2 \overline{E} = \mu_0 \sigma \frac{\partial \overline{E}}{\partial t} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \overline{E}}{\partial t^2}$$

Esto es la ecuación de onde amortiguada Tomardo como solvesión α : $E = (E_1, E_2, E_3), \text{ tal que: } E_2 = E_0 e^{-(\omega t - B_1)} e^{-\alpha t}. \text{ Entences, para } 2$

$$\frac{\partial^2 \mathcal{E}_2}{\partial z^2} = \mu_0 \sigma \frac{\partial \mathcal{E}_2}{\partial t} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathcal{E}_2}{\partial t^2}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2}{\partial t^2} \left[E_3 e^{i(\omega t - 2t) - \alpha t} \right] = \mu_0 \sigma \frac{\partial}{\partial t} \left[E_0 e^{i(\omega t - Bz) - \alpha t} \right] + \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \left[E_0 e^{i(\omega t - Bz) - \alpha t} \right]$$

Tumentu Eo to A eqt >0 Yte .

$$\Rightarrow (\alpha + i\beta)^2 = i\mu_0 \sigma \omega - \frac{\omega^2}{c^2}$$

Analitanto Las partes reales e imaginarias

$$\alpha^2 - \beta^2 = -\frac{\omega^2}{c^2}$$
 $\Lambda = 2\alpha\beta = 400\omega$

De
$$2AB = \mu_0 \sigma \omega \Rightarrow B = \frac{\mu_0 \sigma \omega}{2R}$$
, extences

$$\Rightarrow q^1 - \frac{k_0^2 \sigma^1 \omega^2}{qq^2} = -\frac{\omega^2}{c^2}$$

$$\Rightarrow (2a^{2})^{2} + 2(74)(\frac{\omega^{2}}{c^{2}}) + (\frac{\omega^{1}}{c^{2}})^{2} = (4000)^{2} + (-\frac{\omega^{2}}{c^{2}})^{2}$$

$$\Rightarrow 74^{2} + \frac{\omega^{2}}{c^{2}} = \sqrt{k_{0}^{2} \sigma^{2} + \frac{\omega^{2}}{c^{4}}} \omega$$

$$\Rightarrow \qquad q^2 = \left[\sqrt{\frac{\mu_0^7 \sigma' c^4}{\omega^2} + 1} - 1 \right] \frac{\omega^2}{7 c^2}$$

$$\Rightarrow q = \sqrt{\frac{\mu_0^2 \sigma^2 c^4}{\omega^2} + 1} - 1 \frac{\omega}{\sqrt{2}c}$$

Tumundo para un buen conductor la condición: 40002>>> 1

$$\Rightarrow q \approx \sqrt{\frac{\mu_0 \sigma c^2}{\omega} - 1} \frac{\omega}{\pi c}$$

Si: 0000 9,B 000. Recordande que: Ez=Eo e at-iBZ-az por tanto E 00 (Totalmente)

can be anterior, so be time at a skin-depth's como. $S' = \frac{1}{4}$. Para este coso: $S = \sqrt{\frac{1}{\mu_0 \sigma \omega}}$

3.- Hep structure: Mostrar que el ratio: c/a, para una estructura hexagonal compacta ideal, es: $(8/3)^{1/2} \approx 1.633$. Si c/a es significativamente grande que dicho valor, la estructura cristalina debe ser considerada como una composición de planos de atomos compactos, con planos no apilados.

Sea one estructiva hexagenal compacts (HGP). Notes que el numero de consideración de A es 6, y el numero de coordinación de a tunbien

En el curo ideal de un empagnetamiento compacto, sí se quisiena agregar on atomo en el silio intersticio de ABC, est deberia see equidistante a A, B y d.

Sea D in nuevo atomo en el interstrao del tetraedro: AABG. Entenco.

Sea F la imagen de la perpendicular desde D a la bake: AAB Observer que. DAFA, es un trangulo isuceles con los angulos de 300. Entenas.

$$\overline{AF} = \frac{1}{\sqrt{3}} q$$

Ahora, de: d(A, D)= AD, y del trovema Le pitagoras en DADF

$$\overline{AD}^2 = \overline{AF}^2 + \overline{FD}^2$$

$$\Rightarrow \overline{AO} = \sqrt{\frac{1}{3}a^2 + \overline{FD}^2}$$

concerned que: FD es colineal con Dd Entences FO = 1 OF Sea: OF = C. Entencer.

6

$$\overline{A0} = \sqrt{\frac{1}{3} q^2 + \frac{c^2}{4}}$$

$$\Rightarrow \frac{7}{3}q^1 = \frac{c^2}{4}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{c}{4}\right)^2 = \frac{8}{3}$$

$$= \frac{8}{4} = \sqrt{\frac{8}{3}} \approx 1.633$$

